

気相成長株式会社

本社住所	東京都小金井市東町4-26-20				
代表者	町田 英明	設立年月	平成20年7月29日	資本金	4百50万円
経営理念	顧客満足度を優先した研究開発型企业をめざす				
業務分野	ファインケミカル				
連絡先	042-401-1783	HPアドレス	http://kiso-h-seicho.com/		

事業内容のご紹介

化学気相成長（CVD）に関する研究、開発、成膜委託実験、原料販売、装置の開発・販売

会社のPR

化学気相成長（CVD）法は、揮発したガスを物体の表面で化学反応を起させ、表面をコーティングする方法です。物理気相成長（PVD）と異なり方向性が無く、段差被膜性（ステップカバレッジ）に優れるため、集積回路製造のコア技術であるが、成膜には熟練が必要である。

代表者の町田は長年CVD原料の研究開発に携わり、その他の社員もCVD技術に関するスペシャリストです。多くの大学と共同研究を行い、新規原料や成膜技術の研究開発に実績をあげてきました。CVDに関する職人集団である当社は、CVDに関して、原料の探索や合成、特性の解析、成膜条件の解析、装置設計などあらゆる技術に対応できます。CVD薄膜のデパートといえる当社へ何なりとご相談ください。迅速に解決いたします。以下に、当社の事業を紹介します。

化学気相成長装置を用いた委託実験

各種のCVD実験装置を備えており、半導体新規プロセス用の原料探索や基礎実験の委託事業を行っています。成膜メカニズムを解析する高度な技術を有するので、短期間に低コストで成膜技術を提供いたします。

新規化学気相成長用原料の開発と成膜評価

薄膜太陽電池やLED等の半導体などを製造する最先端のCVD原料の提案、原料合成及び精製、合成プロセスの開発を行っています。これまでに成膜が困難であった新規薄膜を開発いたします。

少量高付加価値原料の製造・販売

当社のホームページに掲載している周期律表の元素記号をクリックするとその金属のCVD原料が表示されます。表示される化合物及びその水素を重水素に置き換えた化合物は、すべて合成し、供給することができます。世界中で当社でしか供給できないCVD原料は多数あります。

化学気相成長装置の研究開発

原料及びプロセスに関して、スクリーニングから高精度の成膜まで一連の実験を短期間に集結させる小型研究用CVD装置の設計、作成、販売をしています。研究目的に合致したあらゆるタイプのCVD装置を提供します。

Periodic table

I a																	0
H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	III a	IV a	V a	VI a	VII a	VIII a			I b	II b	Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac															
		Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu		
		Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lw		

当社のホームページの周期律表です。青の元素のCVD原料を提供できます。

代表者のメッセージ

新しい薄膜開発は巧みの技で解決します。